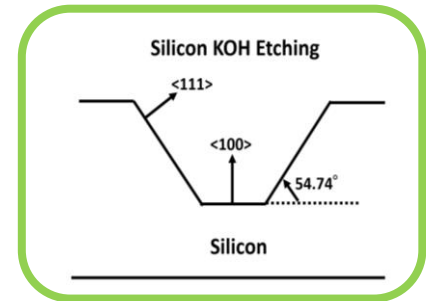
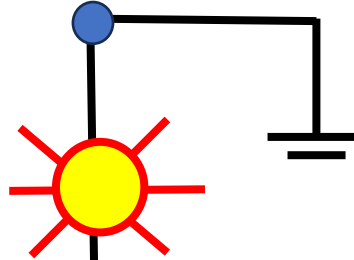


High Energy Ion 打ち込み工程の追加以外は、  
従来の格安シングル接合型太陽電池と  
製法は全く同一で生産できます。



- Vout < 0



+++++  
Vout=0.500000 RN=0.600000 としています。  
+++++

DP=100.000000 の場合：

VBP=0.324852

VMAX=EG-VBP-Vout=0.285148

DNS=430.800000

A=DNS/DP=4.308000

QN=DNS\*RN\*RPI=458.143678

VV=DNS\*RN\*RN/Esi=0.239333

XJ=RN\*log(sqrt(A))=0.725100

WWD=2\*WD=2\*Y\*RN=4.581438

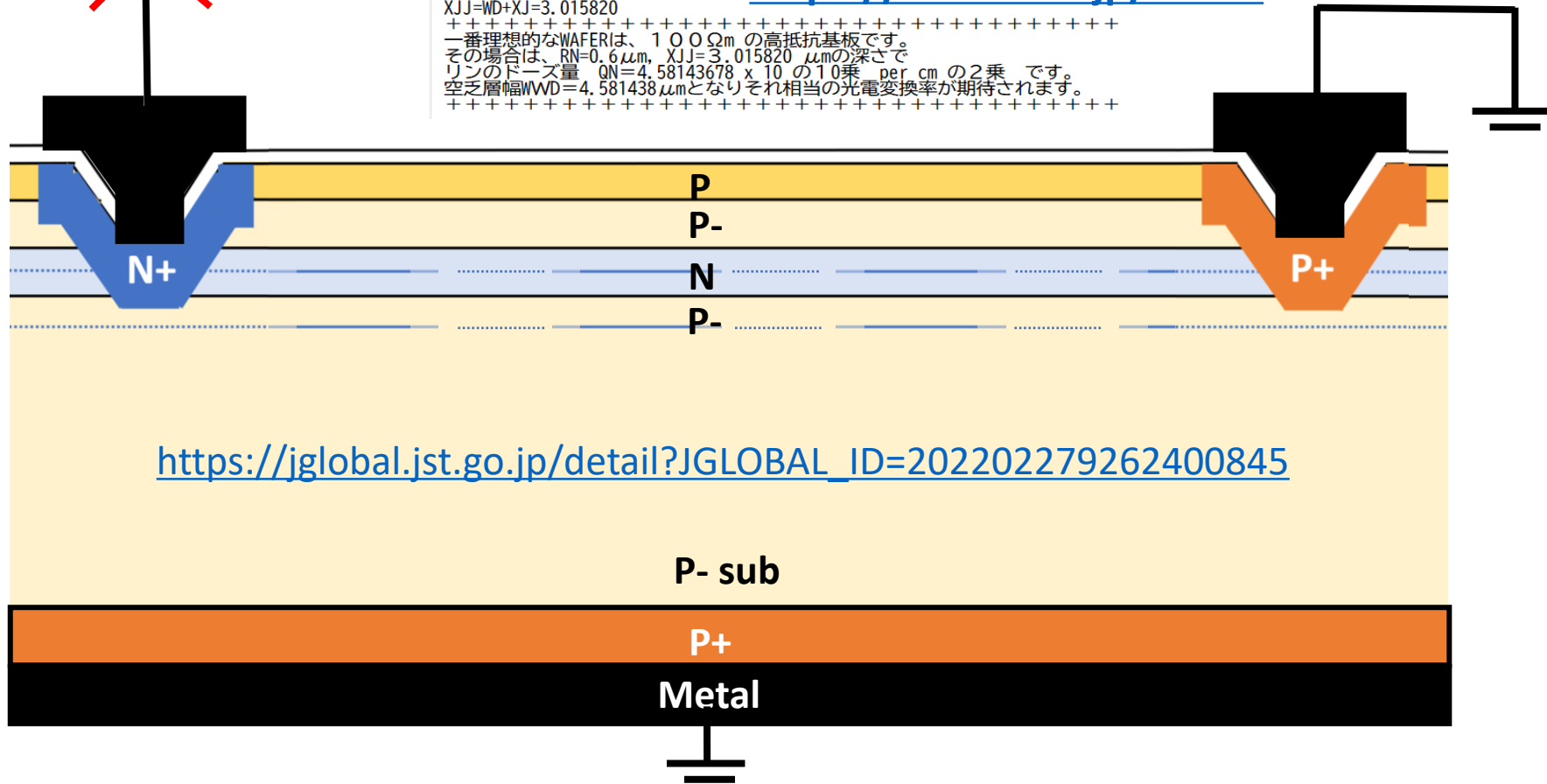
VM=-VV\*W=0.285225

XJJ=WD+XJ=3.015820

+++++  
一番理想的なWAFERは、100Ωmの高抵抗基板です。  
その場合は、RN=0.6μm, XJJ=3.015820μmの深さで  
リンのドーズ量 QN=4.58143678 x 10<sup>10</sup> の10乗 per cm の2乗 です。  
空乏層幅WWD=4.581438μmとなりそれ相当の光電変換率が期待されます。  
+++++

合同会社Locomtec/萩原aips研究所

<https://locomtec.jp/harl-1>



[https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL\\_ID=202202279262400845](https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202202279262400845)

P- sub

P+

Metal